

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-268794

(43)Date of publication of application : 15.10.1996

(51)Int.Cl.

C30B 15/20
C30B 29/06
// H01L 21/208

(21)Application number : 07-100173

(71)Applicant : SUMITOMO SITIX CORP

(22)Date of filing : 30.03.1995

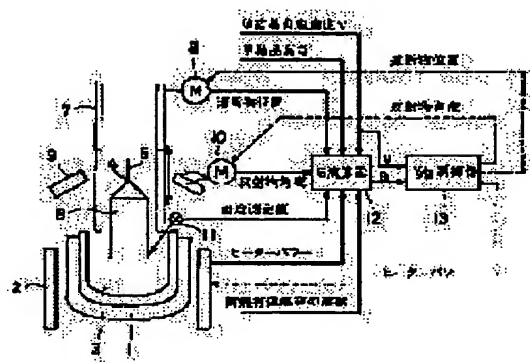
(72)Inventor : KAJITA EIJI
HORAI MASATAKA

(54) METHOD FOR GROWING SINGLE CRYSTAL SILICON

(57)Abstract:

PURPOSE: To control a position where an OSF ring is generated with high accuracy by determining the temp. distribution of the inside part of a single crystal by a temp. distribution calculation over the entire part of the furnace inside by using a heat transfer calculation, and shutting off and/or reflecting the radiation from a melt.

CONSTITUTION: The single crystal 6 pulled up from a crucible 1 is introduced into a cylindrical radiation shielding object 7 enclosed by plural radiation reflectors 9. The temp. at the point of a specific distance from the solid-liquid boundary on the surface of the single crystal 6 is then measured by a temp. measuring meter 11 and is inputted to a G arithmetic and logic unit 12. Simultaneously the position information of the radiation shielding object 7 from a driving section 8, the angle information of the radiation reflectors 9 from a driving section 10, the length and growth speed V (mm/min) of the single crystal 6 under growth, the shape at the boundary of the single crystal 6 and the melt 3 and the power of the heater 2 are inputted to the G arithmetic and logic unit 12 by which the temp. gradient $G(^{\circ}\text{C}/\text{m})$ in the crystal axis direction from the m. p. of silicon to 1300°C is determined. The temp. distribution calculation over the entire part of the furnace inside is executed by the heat transfer calculation and the shielding and reflection of the radiation from the melt are so controlled that the ratio $V/G(\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}, \text{min})$ attains a target value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.07.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2826589

[Date of registration] 18.09.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-268794

(43) 公開日 平成8年(1996)10月15日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 3 0 B 15/20			C 3 0 B 15/20	
29/06	5 0 2	7202-4G	29/06	5 0 2 E
// H 0 1 L 21/208			H 0 1 L 21/208	P

審査請求 未請求 請求項の数 3 F D (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平7-100173

(22) 出願日 平成7年(1995)3月30日

(71) 出願人 000205351

住友シチックス株式会社
兵庫県尼崎市東浜町1番地

(72) 発明者 堀田 栄治

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地
住友シチックス株式会社九州事業所内

(72) 発明者 宝来 正隆

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地
住友シチックス株式会社九州事業所内

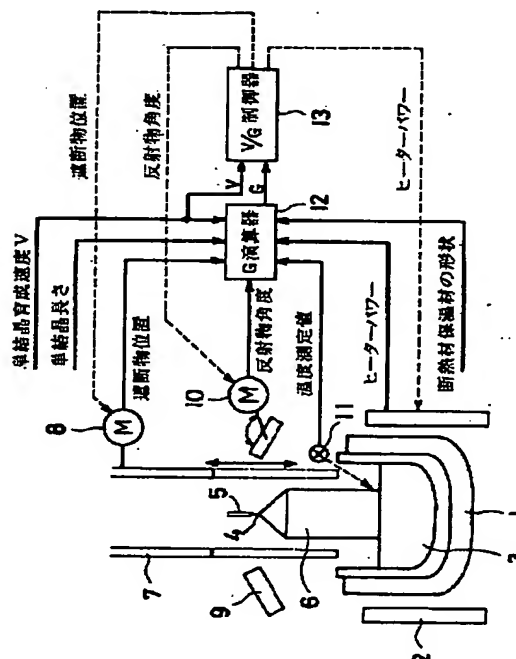
(74) 代理人 弁理士 生形 元重 (外1名)

(54) 【発明の名称】 単結晶シリコン育成方法

(57) 【要約】

【目的】 シリコンの融点から1300℃までの結晶軸方向の温度勾配G (℃/mm) に対する結晶育成速度V (mm/min) の比V/G (mm²/℃・min) を高精度に制御し、狙いとする位置にOSFリングを発生させる。

【構成】 伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算によりGを求める。輻射遮断物7または輻射反射物9により融液からの輻射を制御してGを操作する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 チョクラスキー法によってシリコン単結晶を製造する際に、伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算により単結晶内部の温度分布を求め、求めた温度分布を用いて融液からの輻射を遮断および／または反射することにより、単結晶内部の温度分布を操作することを特徴とする単結晶シリコン育成方法。

【請求項 2】 伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算により、シリコンの融点から 1300℃までの結晶軸方向の温度勾配 G (℃/mm) を求め、結晶育成速度 V (mm/min) と求めた温度勾配 G (℃/mm) との比 V/G (mm²/℃・min) が目標値に制御されるように、 V を操作すると共に融液からの輻射の遮断および／または反射により G を操作することを特徴とする請求項 1 に記載の単結晶シリコン育成方法。

【請求項 3】 単結晶周囲の温度計測値により温度分布計算を補正することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の単結晶シリコン育成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、チョクラスキー法（以下 C Z 法という）によるシリコン単結晶の育成方法に関し、更に詳しくは、単結晶の育成中にその内部の温度分布を操作して結晶品質を制御する単結晶育成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 高集積半導体素子材料として用いられているシリコン単結晶の製造方法は種々あるが、工業的に量産が可能な方法としては主に C Z 法が採用されている。C Z 法の実施状態を図 3 に示す。

【0003】 C Z 法では通常、内側が石英、外側が黒鉛で構成された二重構造の坩堝 1 が用いられる。坩堝 1 内に収容された原料シリコンは坩堝 1 の外側に配置されたヒーター 2 により加熱されて溶融する。そのシリコン融液 3 は、下端に種結晶 4 に取り付けられたワイヤ 5 を上昇させることにより、坩堝 1 から徐々に引き上げられる。このとき坩堝 1 および種結晶 4 を回転させる。これによりシリコン融液 3 が凝固した円柱状の単結晶 6 が育成される。通常採用される結晶育成速度は 1.0～2.0 mm/min である。

【0004】 このような C Z 法によるシリコン単結晶の育成では、単結晶をウェーハに加工したのち熱処理を行うことによって、ウェーハ面に OSF リングと呼ばれるリング状の酸誘起積層欠陥が発生することが知られている。

【0005】 OSF リングが発生すると、その内側領域では結晶育成中に成長した熱的安定性の高い酸素析出物が 10^8 cm⁻³ 程度の高密度で分布し、ゲート酸化膜の耐圧特性が低下する。一方、OSF リングの外側領域では、酸化膜耐圧特性は良好であるが、大きさが約 400

nm の転位クラスターが約 10^3 個/cm² の密度で発生する。このように、OSF リングを境に内側と外側とではウェーハの物理的性質が大きく異なるのである。

【0006】 C Z 法により製造されるシリコン単結晶は高集積半導体素子材料に用いられるが、高集積半導体素子の信頼性および歩留は単結晶ウェーハの物理的性質に強く依存するため、C Z 法によるシリコン単結晶の育成では OSF リングの位置を制御し、狙いとする位置に OSF リングを発生させることが重要な技術となる。

【0007】 これに関連して本発明者らは、結晶育成速度を V (mm/min) とし、シリコンの融点から 1300℃までの温度範囲における結晶軸方向の温度勾配を G (℃/mm) とするとき、 V/G (mm²/℃・min) により OSF リングの発生位置が一義的に決まることを見出し、特願平 6-148939 号により、 V/G を 2.5 以上にして OSF リングを素子製造に使用されないウェーハの外周部に発生させると共に、1150℃から 1000℃までの温度範囲における冷却速度を 2.0℃/min 以下として OSF リングの内側での酸素析出物の分布密度を低下させる単結晶製造法を提案した。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】 本発明者らが先に提案した単結晶製造法では、狙いとする位置に OSF リングを発生させるために、 V/G を高精度に制御することが重要な技術となっている。

【0009】 しかし、C Z 法によるシリコン単結晶の育成では、図 3 に示すように、育成中の単結晶 6 が融液 3 から輻射熱を受ける一方、単結晶 6 からの輻射熱が存在する。単結晶 5 の成長に伴いその長さが変化するため、単結晶 6 からの輻射熱量の軸方向分布は時々刻々と変化する。そのため、 G は単結晶 6 の育成中一定には維持されない。 V/G を制御するためには、 V だけでなく G の検出および操作が必要であるが、上述したように実際の操業では V の検出および操作が困難なため、 V/G の制御は非常に難しく、従って、狙いとする位置に OSF リングを発生させることは容易でない（図 2 中の従来法参照）。

【0010】 本発明の目的は、育成中の単結晶内部の温度分布を意のままに操作することにより、 V/G の制御ひいては OSF リング発生位置の制御を高精度に行い得る単結晶シリコン育成方法を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】 本発明の単結晶シリコン育成方法は、C Z 法によってシリコン単結晶を製造する際に、伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算により単結晶内部の温度分布を求め、求めた温度分布を用いて融液からの輻射を遮断および／または反射することにより、単結晶内部の温度分布を操作するものである。

【0012】 V/G の制御では、伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算により、シリコンの融点から 130

0℃までの結晶軸方向の温度勾配 G (℃/mm) を求め、結晶育成速度 V (mm/min) と求めた温度勾配 G (℃/mm) との比 V/G (mm²/℃・min) が目標値に制御されるように、 V を操作すると共に融液からの輻射の遮断および/または反射により G を操作する。

【0013】望ましくは、単結晶周囲の温度計測値により温度分布計算を補正する。

【0014】

【作用】 V/G の制御では、単結晶の育成中に単結晶軸方向の温度勾配を制御することが不可欠の技術である。この制御技術では、育成中の単結晶内部の温度分布を求めることと、その温度分布を操作することの2つが必要である。 V/G の制御で言えば G を求めることと G を操作することが共に必要である。

【0005】単結晶内部の温度分布を求めることについては、単結晶周囲の温度を多くの箇所で測定することにより一応これが可能となるが、炉内に多くの測定器を設置することになるため、炉内や炉内で育成中の単結晶の汚染が問題になる。そこで本発明では伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算によりこれを行う。

【0006】具体的には、例えば①炉内全体の輻射熱交換、②単結晶と融液との界面形状、③ヒータパワーおよび④単結晶育成速度等の各項目を考慮して伝熱計算を行うことより、単結晶内部の温度分布を求め、 V/G の制御では G を求める。

【0007】ここで①の項目、すなわち炉内全体の輻射熱交換では、炉内の保温材および断熱材の形状、育成中の単結晶の長さの他に、本発明では融液からの輻射の遮断や反射を行うので、遮断物や反射物の現在位置なども考慮する必要がある。また、②の項目、すなわち単結晶と融液の界面形状については、Stefan条件とBoundry-fitted法から求めることができる。

【0008】伝熱計算を用いた炉内温度分布計算によれば、温度測定点の数を少なくして、単結晶内部の温度分布を高精度に求めることができる。なお、この場合の温度測定は温度分布計算の補正のためであるので必ずしも必要ではない。温度測定を行う場合、結晶表面温度を固液界面から一定の距離で測定することが好ましいが、本発明では温度分布計算を炉内全体にわたって行うために、単結晶の温度分布に応答する輻射遮断物や保温材の特定位置の温度を測定してもよい。

【0009】温度分布の操作については、本発明では融液からの輻射を遮断および/または反射する。単結晶と融液との界面の温度は一定であるので、融液から単結晶への輻射を遮断して単結晶の温度を下げることにより、単結晶軸方向の温度勾配は大となり、 V/G の制御では G を大きくすることができる。一方、融液の上方に反射率の高い反射物を設置して融液からの輻射を単結晶へ反射することにより、単結晶の温度が高くなって単結晶軸方向の温度勾配が小となり、 V/G の制御では G を小さく

くすることができる。また、遮断および反射の両方を同時に用いて G を操作することも可能である。

【0010】かくして V/G の高精度な制御が可能となり、狙った位置にOSFリングを発生させることができる。

【0011】

【実施例】図1に本発明を実施するのに適した装置構成を示す。

【0012】図1において、7は単結晶6の引き上げ路を包囲するように、坩堝2の上方に設けた円筒状の輻射遮断物である。輻射遮断物7は例えばカーボンからなり、坩堝1内の融液3から引き上げられる単結晶6を收容して、融液3から単結晶6への輻射を遮断する。また、その遮断量をコントロールするために、輻射遮断物7は駆動部8により上下に移動させられる。

【0013】9は輻射遮断物7の昇降路を取り囲むように、周方向に配列設置された複数の輻射反射物である。輻射反射物9は例えば表面を鏡面に研磨したMo板からなり、融液3からの輻射を単結晶6に反射させる。また、その反射量をコントロールするために、それぞれの輻射反射物9は駆動部10により角度が調節される。

【0014】11は温度測定計であり、単結晶6の表面の固液界面から一定距離の点の温度を測定する。

【0015】12はシリコンの融点から1300℃までの温度範囲における結晶軸方向の温度勾配 G を求める G 演算器である。 G 演算器12には駆動部8から輻射遮断物7の位置情報が与えられる。また、駆動部10からは輻射反射物9の角度情報が、温度測定計11からは単結晶周囲の温度情報がそれぞれ与えられる。更には、炉内の保温材および断熱材の形状、育成中の単結晶6の長さおよび育成速度 V 、単結晶5と融液3との界面形状、ヒータ2のパワーについての各情報も与えられる。

【0016】そして G 演算器12は、単結晶6の温度測定値を除くこれらの情報を用いて伝熱計算により炉内全体の温度分布計算を行い、更に温度測定値を用いてその温度分布計算の補正を行うことにより G を求める。

【0017】13は V/G 制御器である。 V/G 制御器13は求められた G と単結晶育成速度 V とから V/G を計算すると共に、その計算値が V/G 設定値と一致するように V を操作し、合わせて輻射遮断物7の位置や輻射反射物9の角度を駆動部8、10に指示して G を操作する。また必要に応じてヒータ2のパワーも操作する。

【0018】かくして、単結晶育成の全期間にわたって V/G がその設定値に制御される。その結果、育成された単結晶をウェーハに加工しそのウェーハを熱処理したときに生じるOSFリングが所定位置に制御される。

【0019】すなわち、ある仮定(C_1 , **, C_2 , **, D_1 , **, D_2 の定数設定値)の下での計算による推定であるが、 V/G によって結晶内の $T=1300℃\sim 1250℃$ における点欠陥の濃度(空孔と格子間シリコン)が

ほぼ決まり、この点欠陥がその後、酸素と反応して種々のサイズおよび密度の酸素析出物またはその2次欠陥(転位)等が発生させる。そのため、 V/G を一定に制御することにより、OSFリングの発生位置が結晶全体にわたって一定になる。更に、酸素析出物等の欠陥の分布(面内および軸方向でのサイズ-密度分布)も一定になる。

【0020】ただし、結晶育成末期のTail部形成時およびその後の融液からの結晶切り離し時には、結晶が急速に冷却される。このとき、Top側は低温からTail側は高温から急冷されるために、これらの部分は均一な欠陥分布とはならない。そのため、育成初期および後期に対応する部分では、OSFリングの発生位置が制御されない。均一にならない部分の欠陥は、 $100 \sim 850^{\circ}\text{C}$ 以下で結晶冷却時に形成される欠陥であり、非常に小さい析出物である。一方、 $1000 \sim 850^{\circ}\text{C}$ 以上で形成される欠陥は大きく安定で、結晶全長にわたって均一になる。このような欠陥はデバイスプロセス中でも安定であり、確実にデバイス活性領域(表面近傍)に残留し、特性を劣化させる。

【0021】次に図1に示す装置を用いて実際に V/G を制御した結果を説明する。

【0022】〔実施例1〕直径16"の石英ルツボに高純度多結晶シリコン50kgを入れ、ボロンをドーブし、多結晶シリコンを加熱溶解したのち、直径150mmで結晶育成方位が〈100〉の単結晶を長さ1000mm育成した。単結晶育成中は、輻射温度計で結晶の表面温度を計測して、単結晶温度分布計算システムで V/G を計算し、 V/G が $0.28\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$ (一定)になるように、単結晶育成速度を操作すると共に、単結晶の周りに配した内径300mm×厚さ30mmのカーボンからなる円筒状の輻射反射物を上下に移動させた。

【0023】育成した単結晶から結晶軸方向と平行にサンプルを切り出し熱処理した後、OSFリングの発生位置を調べた。OSFリングは育成初期の20mmと育成後期の100mmの部分を除き、中心から約67mmの位置に発生していた。

【0024】〔実施例2〕直径16"の石英ルツボに高純度多結晶シリコン50kgを入れ、ボロンをドーブし、多結晶シリコンを加熱溶解したのち、直径150mmで結晶育成方位が〈100〉の単結晶を長さ1000mm育成した。単結晶育成中は、輻射温度計で結晶の表面温度を計測して、単結晶温度分布計算システムで V/G を計算し、 V/G が $0.22\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$ (一定)になるように、単結晶育成速度を操作すると共に、単結晶の周りに配した表面を鏡面に研磨した5枚のMo板製輻射反射物(1枚の寸法は250mm×150mm)の角度を操作した。

【0025】育成した単結晶から結晶軸方向と平行にサンプルを切り出し熱処理した後、OSFリングの発生位

置を調べた。OSFリングは育成初期の20mmと育成後期の100mmの部分を除き、中心から約15mmの位置に発生していた。

【0026】〔実施例3〕直径16"の石英ルツボに高純度多結晶シリコン50kgを入れ、ボロンをドーブし、多結晶シリコンを加熱溶解したのち、直径150mmで結晶育成方位が〈100〉の単結晶を長さ1000mm育成した。単結晶育成中は、輻射温度計で結晶の表面温度を計測して、単結晶温度分布計算システムで V/G を計算し、単結晶の育成長さが500mmまでは V/G が $0.22\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$ 、育成長さが500mm以降は $0.28\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$ になるように、単結晶育成速度を操作すると共に、カーボン輻射反射物の位置およびMo輻射反射物の角度を操作した。

【0027】育成した単結晶から結晶軸方向と平行にサンプルを切り出し熱処理した後、OSFリングの発生位置を調べた。OSFリングは20mmから450mmまでの部分においては中心から約15mmの位置に発生し、450mmからは徐々に外周へ移り、550mmから100mmを残すまでの部分においては中心から約67mmの位置に発生した。

【0028】各実施例におけるOSFリング発生位置を図2に示す。また、比較のために V/G を制御しない従来法の場合のOSFリング発生位置を示す。同図からわかるように、本発明により V/G の高精度な制御が可能となり、狙いとする位置にOSFリングを発生させることが可能となる。ちなみに、従来法は結晶の中心から35mmの位置にOSFリングを発生させることを狙って結晶育成を行った場合であるが、実際のOSFリング発生位置は狙い位置から大きくずれている。

【0029】

【発明の効果】以上に述べた通り、本発明の単結晶シリコン育成方法は伝熱計算を用いた炉内全体の温度分布計算により単結晶内部の温度勾配を求め、且つ融液からの輻射の遮断および/または反射により単結晶内部の温度勾配を操作することにより、 V/G の高精度な制御を可能とし、これにより狙いとする位置にOSFリングを発生させることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を実施するのに適した装置の構成図である。

【図2】本発明の効果を示すグラフである。

【図3】チョクラルスキー法の実施状態を示す概略断面図である。

【符号の説明】

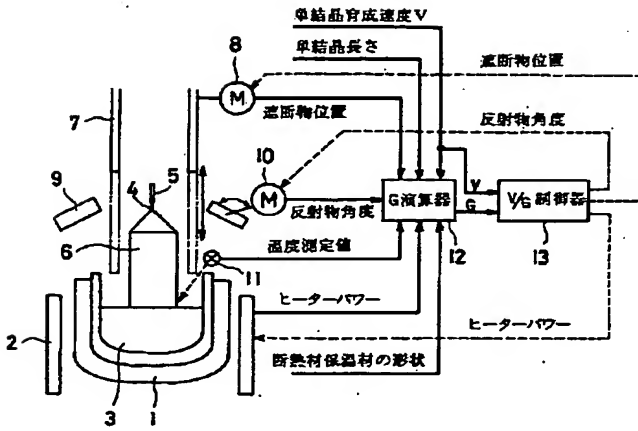
- 1 坩堝
- 2 加熱ヒーター
- 3 融液
- 4 種結晶
- 5 ワイヤ

6 単結晶
7 輻射遮断物

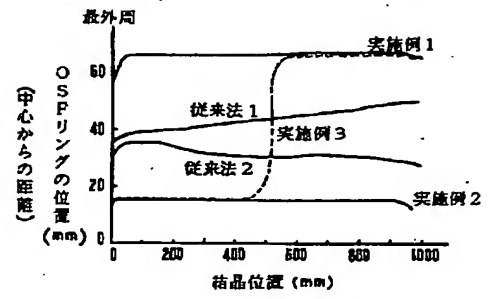
* 9 輻射反射物

*

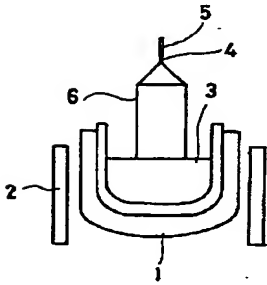
【図 1】



【図 2】



【図 3】



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-268794

(43)Date of publication of application : 15.10.1996

(51)Int.Cl.

C30B 15/20
C30B 29/06
// H01L 21/208

(21)Application number : 07-100173

(71)Applicant : SUMITOMO SITIX CORP

(22)Date of filing : 30.03.1995

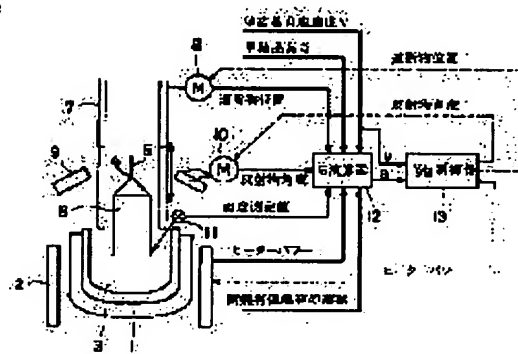
(72)Inventor : KAJITA EIJI
HORAI MASATAKA

(54) METHOD FOR GROWING SINGLE CRYSTAL SILICON

(57)Abstract:

PURPOSE: To control a position where an OSF ring is generated with high accuracy by determining the temp. distribution of the inside part of a single crystal by a temp. distribution calculation over the entire part of the furnace inside by using a heat transfer calculation, and shutting off and/or reflecting the radiation from a melt.

CONSTITUTION: The single crystal 6 pulled up from a crucible 1 is introduced into a cylindrical radiation shielding object 7 enclosed by plural radiation reflectors 9. The temp. at the point of a specific distance from the solid-liquid boundary on the surface of the single crystal 6 is then measured by a temp. measuring meter 11 and is inputted to a G arithmetic and logic unit 12. Simultaneously the position information of the radiation shielding object 7 from a driving section 8, the angle information of the radiation reflectors 9 from a driving section 10, the length and growth speed $V(\text{mm}/\text{min})$ of the single crystal 6 under growth, the shape at the boundary of the single crystal 6 and the melt 3 and the power of the heater 2 are inputted to the G arithmetic and logic unit 12 by which the temp. gradient G ($^{\circ}\text{C}/\text{m}$) in the crystal axis direction from the m. p. of silicon to 1300°C is determined. The temp. distribution calculation over the entire part of the furnace inside is executed by the heat transfer calculation and the shielding and reflection of the radiation from the melt are so controlled that the ratio $V/G(\text{mm}^2/^{\circ}\text{C}, \text{min})$ attains a target value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.07.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2826589

[Date of registration] 18.09.1998

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The single-crystal-silicon training approach characterized by operating the temperature distribution inside single crystal by searching for the temperature distribution inside single crystal by temperature-distribution count in [whole] a furnace which used the thermal rating, using the temperature distribution searched for, and intercepting and/or reflecting the radiation from melt in case a silicon single crystal is manufactured with the Czochralski method.

[Claim 2] By temperature-distribution count in [whole] the furnace using a thermal rating, the temperature gradient G of the crystal orientation from the melting point of silicon to 1300 degrees C (degree C/mm) is searched for. the ratio of the crystal training rate V (mm/min) and the temperature gradient G (degree C/mm) searched for -- so that V/G (mm²/** and min) may be controlled by desired value The single-crystal-silicon training approach according to claim 1 characterized by operating G by cutoff and/or reflection of the radiation from melt while operating V.

[Claim 3] The single-crystal-silicon training approach according to claim 1 or 2 characterized by amending temperature-distribution count with the thermometry value of the perimeter of a single crystal.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the single-crystal-growth approach which operates the temperature distribution of the interior and controls crystal quality during training of a single crystal in more detail about the training approach of the silicon single crystal by the Czochralski method (henceforth a CZ process).

[0002]

[Description of the Prior Art] Although there are various the manufacture approaches of the silicon single crystal used as a high integrated semiconductor component ingredient, as an approach of mass-producing, the CZ process is mainly adopted industrially. The operation condition of a CZ process is shown in drawing 3.

[0003] In a CZ process, the crucible 1 of the dual structure by which the inside was constituted from a quartz and the outside was constituted from a graphite is usually used. The raw material silicon held in crucible 1 is heated at the heater 2 arranged on the outside of crucible 1, and is fused. The silicon melt 3 can be gradually pulled up from crucible 1 by raising the wire 5 attached in the lower limit at seed crystal 4. At this time, crucible 1 and seed crystal 4 are rotated. The single crystal 6 of the shape of a cylinder which silicon melt 3 solidified by this is raised. usually, the crystal training rate adopted -- 1.0 - 2.0 mm/min it is .

[0004] After processing a single crystal into a wafer, it is known for training of the silicon single crystal by such CZ process by performing heat treatment that the acid induction stacking fault of the shape of a ring called an OSF ring to a wafer side will occur.

[0005] If an OSF ring is generated, in the inside field, an oxygen sludge with the high thermal stability which grew during crystal training will be distributed by the high density which is about 10^6 cm^{-3} , and the proof-pressure property of gate oxide will fall. On the other hand, the rearrangement cluster whose magnitude is about 400nm in the outside field of an OSF ring although the oxide-film proof-pressure property is good is about 10^3 . An individual / cm^2 It generates by the consistency. Thus, the inside differs in the physical property of a wafer greatly from an outside bordering on an OSF ring.

[0006] Although the silicon single crystal manufactured by the CZ process is used for a high integrated semiconductor component ingredient, in order that the dependability and the yield of a high integrated semiconductor component may depend to the physical property of a single crystal wafer strongly, the location of an OSF ring is controlled by training of the silicon single crystal by the CZ process, and it becomes an important technique to make the location made into an aim generate an OSF ring.

[0007] When this invention persons set a crystal training rate to $V \text{ (mm/min)}$ in relation to this and the temperature gradient of the crystal orientation in the temperature requirement from the melting point of silicon to 1300 degrees C is set to $G \text{ (degree C/mm)}$, That the generating location of an OSF ring is uniquely decided by $V/G \text{ (mm}^2/\text{** and min)}$ by the header and Japanese Patent Application No. No. 148939 [six to] While generating the periphery section of the wafer which makes $V/G \geq 2.5$ or more and is not used for component manufacture in an OSF ring They are 2.0 degrees C / min about the cooling rate in the temperature requirement from 1150 degrees C to 1000 degrees C. The single crystal manufacturing method to which it considers as the following and the distribution density of the oxygen sludge inside an OSF ring is reduced was proposed.

[0008]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In order that this invention persons may make the location made into an aim generate an OSF ring in the single crystal manufacturing method proposed previously, it is an important technique to control V/G with high precision.

[0009] However, in training of the silicon single crystal by the CZ process, as shown in drawing 3, while the single crystal 6 under training receives radiant heat from melt 3, radiation cooling from a single crystal 6 exists. In order that the die length may change with growth of a single crystal 5, shaft-orientations distribution of the amount of radiation cooling from a single crystal 6 changes every moment. Therefore, G is not maintained by regularity during training of a single crystal 6. Although not only V but G needs detection and operating in order to control V/G, it is not easy to make the location which is very difficult for control of V/G, therefore is made into an aim generate an OSF ring in actual operation, as mentioned above, since detection and actuation of V are difficult (refer to the conventional method in drawing 2).

[0010] When the purpose of this invention operates the temperature distribution inside the single crystal under training at will, control ***** of V/G is to offer the single-crystal-silicon training approach which can control an OSF ring generating location with high precision.

[0011]

[Means for Solving the Problem] In case the single-crystal-silicon training approach of this invention manufactures a silicon single crystal by the CZ process, it operates the temperature distribution inside single crystal by searching for the temperature distribution inside single crystal by temperature-distribution count in [whole] a furnace which used the thermal rating, using the temperature distribution searched for, and intercepting and/or reflecting the radiation from melt.

[0012] In control of V/G, by temperature-distribution count in [whole] a furnace which used the thermal rating The temperature gradient G of the crystal orientation from the melting point of silicon to 1300 degrees C (degree C/mm) is searched for. the ratio of the crystal training rate V (mm/min) and the temperature gradient G (degree C/mm) searched for -- while operating V so that V/G (mm2/** and min) may be controlled by desired value, G is operated by cutoff and/or reflection of the radiation from melt.

[0013] Desirably, the thermometry value of the perimeter of a single crystal amends temperature-distribution count.

[0014]

[Function] In control of V/G, it is an indispensable technique to control the temperature gradient of single crystal shaft orientations during training of a single crystal. Two, operate [searching for the temperature distribution inside the single crystal under training and] those temperature distribution, are required of this control technique. If it says by control of V/G, both the things for which asking for G and G are operated are required.

[0005] About searching for the temperature distribution inside single crystal, although this becomes once possible by measuring the temperature of the perimeter of a single crystal in many parts, since many measuring instruments will be installed in a furnace, contamination of the single crystal under training becomes a problem in a furnace and a furnace. So, in this invention, the temperature-distribution count in [whole] a furnace which used the thermal rating performs this.

[0006] From performing a thermal rating in consideration of each item, such as radiant heat exchange in [whole] ** furnace, an interface configuration of ** single crystal and melt, ** heater power, and ** single-crystal-growth rate, the temperature distribution inside single crystal are searched for, and, specifically, it asks for G by control of V/G.

[0007] Since cutoff and reflection of the radiation from melt are performed to everything but the configuration of the heat insulating material in a furnace, and a heat insulator, and the die length of the single crystal under training by this invention, it is necessary to take into consideration the current position of the blocker or a reflective object etc. by the item of **, i.e., the radiant heat exchange in [whole] a furnace, here. Moreover, it can ask about the item of **, i.e., the interface configurations of a single crystal and melt, from the Boundry-fitted method as Stefan conditions.

[0008] According to the temperature-distribution-in-furnace count using a thermal rating, the number of thermometry points can be lessened and the temperature distribution inside single crystal can be searched for with high precision. In addition, since the thermometry in this case is for amendment of temperature-distribution count, it is not necessarily required. When performing a thermometry, it is desirable to measure crystal skin temperature in a fixed distance from a solid-liquid interface, but in this invention, in order to perform temperature-distribution count over the whole inside of a furnace, the temperature of the specific location of the radiation blocker and heat insulating material which answer the temperature distribution of a single crystal may be measured.

[0009] About actuation of temperature distribution, the radiation from melt is intercepted and/or reflected by this invention. Since the temperature of the interface of a single crystal and melt is fixed, the temperature gradient of single crystal shaft orientations can enlarge G by control of a large next door and V/G by

intercepting the radiation to a single crystal from melt, and lowering the temperature of a single crystal. By installing the high reflective object of a reflection factor above melt, and on the other hand, reflecting the radiation from melt in a single crystal, the temperature of a single crystal becomes high, the temperature gradient of single crystal shaft orientations serves as smallness, and G can be made small by control of V/G. Moreover, it is also possible to use both cutoff and reflection for coincidence, and to operate G.

[0010] Highly precise control of V/G can be attained in this way, and the location aimed at can be made to generate an OSF ring.

[0011]

[Example] The equipment configuration suitable for carrying out this invention to drawing 1 is shown.

[0012] In drawing 1, 7 is the radiation blocker of the shape of a cylinder established above crucible 2, as the raising way of a single crystal 6 is surrounded. It consists of carbon, and the radiation blocker 7 holds the single crystal 6 which can be pulled up from the melt 3 in crucible 1, and intercepts the radiation to a single crystal 6 from melt 3. Moreover, in order to control the amount of cutoff, the radiation blocker 7 is moved up and down by the mechanical component 8.

[0013] 9 is two or more radiation reflective objects by which array installation was carried out in the hoop direction, as the hoistway of the radiation blocker 7 is surrounded. The radiation reflective object 9 consists of an Mo plate which polished the front face to the mirror plane, and makes a single crystal 6 reflect the radiation from melt 3. Moreover, as for each radiation reflective object 9, an include angle is adjusted by the mechanical component 10 in order to control the amount of reflection.

[0014] 11 is a thermometry meter and measures the temperature of the point of fixed distance from the solid-liquid interface of the front face of a single crystal 6.

[0015] 12 is a G computing element which searches for the temperature gradient G of the crystal orientation in the temperature requirement from the melting point of silicon to 1300 degrees C. The positional information of the radiation blocker 7 is given to the G computing element 12 from a mechanical component 8. Moreover, from a mechanical component 10, the temperature information on the perimeter of a single crystal is given for the include-angle information on the radiation reflective object 9 from thermometry 11 [a total of], respectively. Furthermore, each information about the die length of the configuration of the heat insulating material in a furnace and a heat insulator and the single crystal 6 under training and the training rate V, the interface configuration of a single crystal 5 and melt 3, and the power of a heater 2 is also given.

[0016] And the G computing element 12 performs temperature-distribution count in [whole] a furnace by the thermal rating using such information except the thermometry value of a single crystal 6, and asks for G by amending the temperature-distribution count using a thermometry value further.

[0017] 13 is a V/G controller. The V/G controller 13 operates and doubles V, directs the location of the radiation blocker 7, and the include angle of the radiation reflective object 9 to mechanical components 8 and 10, and operates G so that the calculated value may be in agreement with the V/G set point, while calculating the single-crystal-growth rate V to called-for G and V/G. Moreover, the power of a heater 2 is also operated if needed.

[0018] In this way, V/G is controlled by the set point over the whole term of single crystal growth. Consequently, the OSF ring produced when the raised single crystal is processed into a wafer and the wafer is heat-treated is controlled by the predetermined location.

[0019] That is, although it is presumption by the count under a certain assumption (C_v ez, C_i ez, D_v , constant set point of D_i), the concentration (a hole and silicon between grids) of the point defect in $T = 1300$ degrees C - 1250 degrees C of a crystal is mostly decided by V/G, and after that, this point defect reacts with oxygen and generates an oxygen sludge or its secondary defect (rearrangement) of various sizes and a consistency etc. Therefore, the generating location of an OSF ring becomes fixed over the whole crystal by controlling V/G uniformly. Furthermore, distribution (size-density distribution in the inside of a field and shaft orientations) of the defect of an oxygen sludge etc. also becomes fixed.

[0020] However, at the time of the Tail section formation of the crystal training last stage, and the crystal separation from subsequent melt, a crystal is cooled quickly. At this time, it is Top. In a side, since it quenches the Tail side from an elevated temperature, these parts do not serve as uniform defective distribution from low temperature. Therefore, the generating location of an OSF ring is not controlled by the part corresponding to the early stages of training, and an anaphase. The defect of the part which does not become homogeneity is a defect formed below 100-850 degrees C at the time of crystal cooling, and is a very small sludge. On the other hand, the defect formed above 1000-850 degrees C is greatly stable, and becomes homogeneity covering a crystal overall length. Such a defect is stable also in a device process,

remains to a device active region (a near front face) certainly, and degrades a property.

[0021] Next, the result of having actually controlled V/G using the equipment shown in drawing 1 is explained.

[0022] [Example 1] After having put 50kg of high grade polycrystalline silicon into the quartz crucible with a diameter of 16", doping boron and carrying out the heating dissolution of the polycrystalline silicon, crystal training bearing raised the single crystal of <100> die length of 1000mm for the diameter of 150mm. During single crystal growth, the skin temperature of a crystal is measured with an emission pyrometer, and it calculates V/G with a single crystal temperature-distribution computing system, and it moved the radiation reflective object of the shape of a cylinder which consists of carbon with a bore [of 300mm] x thickness of 30mm allotted to the surroundings of a single crystal up and down while it operated a single-crystal-growth rate so that V/G may be set to $0.28\text{mm}^2 / **$, and min (fixed).

[0023] After starting and heat-treating a sample from the raised single crystal to a crystal orientation and parallel, the generating location of an OSF ring was investigated. The OSF ring was generated in location of about 67mm from the core except for the part (20mm in early stages of training, and 100mm) of a training anaphase.

[0024] [Example 2] After having put 50kg of high grade polycrystalline silicon into the quartz crucible with a diameter of 16", doping boron and carrying out the heating dissolution of the polycrystalline silicon, crystal training bearing raised the single crystal of <100> die length of 1000mm for the diameter of 150mm. During single crystal growth, the skin temperature of a crystal was measured with the emission pyrometer, and it calculated V/G with the single crystal temperature-distribution computing system, and it operated the include angle of the radiation reflective object made from five Mo plates (the dimension of one sheet is 250mmx150mm) which allotted the surroundings of a single crystal and polished the front face to the mirror plane while it operated the single-crystal-growth rate so that V/G might be set to $0.22\text{mm}^2 / **$, and min (fixed).

[0025] After starting and heat-treating a sample from the raised single crystal to a crystal orientation and parallel, the generating location of an OSF ring was investigated. The OSF ring was generated in location of about 15mm from the core except for the part (20mm in early stages of training, and 100mm) of a training anaphase.

[0026] [Example 3] After having put 50kg of high grade polycrystalline silicon into the quartz crucible with a diameter of 16", doping boron and carrying out the heating dissolution of the polycrystalline silicon, crystal training bearing raised the single crystal of <100> die length of 1000mm for the diameter of 150mm. During single crystal growth, the skin temperature of a crystal is measured with an emission pyrometer, V/G is calculated with a single crystal temperature-distribution computing system, and $0.22\text{mm}^2 / **$ and min, and training die length are [the training die length of a single crystal / 500mm / V/G] $0.28\text{mm}^2 / **$, and min after 500mm. While operating the single-crystal-growth rate so that it might become, the location of a carbon radiation reflective object and the include angle of Mo radiation reflective object were operated.

[0027] After starting and heat-treating a sample from the raised single crystal to a crystal orientation and parallel, the generating location of an OSF ring was investigated. The OSF ring was generated in location of about 15mm from the core in the part from 20mm to 450mm, moved from 450mm to the periphery gradually, and was generated in location of about 67mm from the core in the part until it leaves 550 to 100mm.

[0028] The OSF ring generating location in each example is shown in drawing 2. Moreover, the OSF ring generating location in the case of the conventional method which does not control V/G for a comparison is shown. As shown in this drawing, highly precise control of V/G is attained by this invention, and it becomes possible to make the location made into an aim generate an OSF ring. Incidentally, although it is the case where aimed at that a conventional method made the location of 35mm generate an OSF ring from the core of a crystal, and crystal training is performed, the actual OSF ring generating location was aimed at, and is greatly shifted from the location.

[0029]

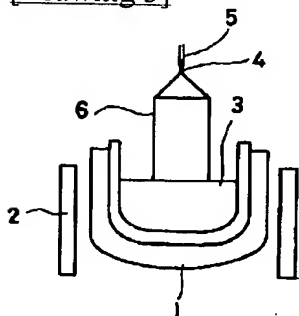
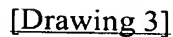
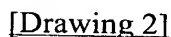
[Effect of the Invention] The single-crystal-silicon training approach of this invention does so the effectiveness of the ability to be able to make the location which enables highly precise control of V/G and is made into an aim by this generate an OSF ring by searching for the temperature gradient inside single crystal by temperature-distribution count in [whole] a furnace which used the thermal rating, and operating the temperature gradient inside single crystal by cutoff and/or reflection of the radiation from melt as stated above.

[Translation done.]

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

[Drawing 1]



[Translation done.]